

課題番号 : F-15-WS-0053  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : GaN デバイスの加工  
Program Title (English) : GaN Device Process  
利用者名(日本語) : 山田義則  
Username (English) : Y.Yamada  
所属名(日本語) : 1) 有限会社ディアックス  
Affiliation (English) : 1) DIAX Inc.

## 1. 概要(Summary)

GaN はウェットエッチングが不可でドライエッチング(RIE)が使用されている。しかし精密制御は不要であり、その代わり GaN/AlGaIn/GaN/ITO 構造を一気にメサエッチングしてデバイスのメサ構造を形成したい。この後、デバイスの外部取り出し電極を形成し、ダイシングしてチップ分離を行う。エッチングの方法や実際の加工の可能性について、また素子作製を進めるための具体的なプロセスについて支援を受けたい。本案件に関し、イオンミリングを用いての加工や素子作製に関し2枚のフォトマスクを用いたパターン形成が必要であることを提案した。

## 2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。